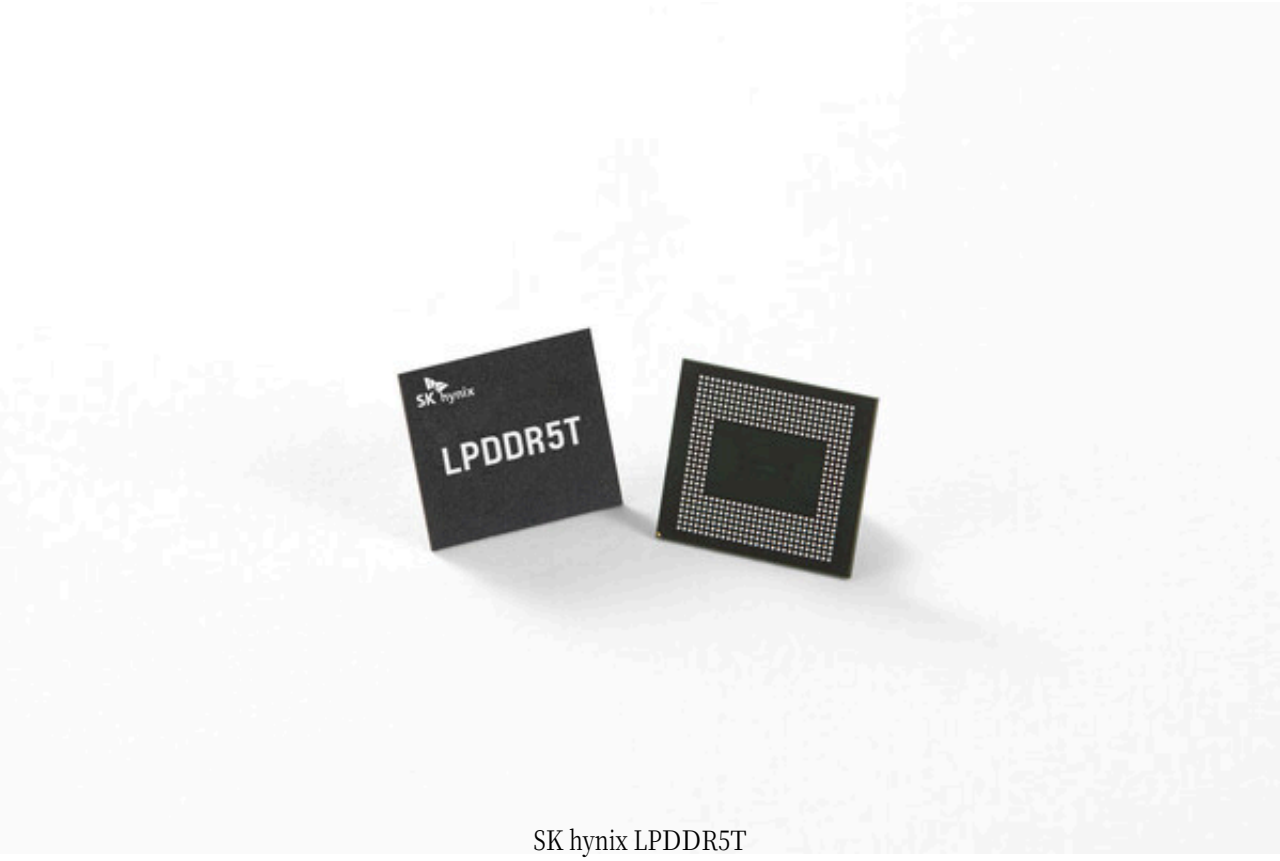
SK海力士LPDDR5T移动DRAM与高通完成性能验证

- 完成与高通最新移动处理器的兼容性验证，正式开始向客户提供产品
- "将通过加强与高通的合作，实现智能手机发展为AI时代的核心应用。"

韩国首尔2023年10月25日 /美通社/ -- SK海力士（或‘公司', https://www.skhynix.com）25日宣布，公司开始推进"LPDDR5T(Low Power Double Data Rate 5 Turbo) DRAM"的商用化*，其目前移动DRAM中可实现9.6Gbps（每秒9.6千兆）最高速度。SK海力士表示，最近获得了将LPDDR5T DRAM适用于美国高通技术公司（Qualcomm Technologies，以下简称高通）最新第三代骁龙8移动平台（Snapdragon ® 8 Gen 3 Mobile Platform）的业内首次认证。



SK hynix LPDDR5T

*LPDDR（低功耗双倍数据速率）：是用于智能手机和平板电脑等移动端产品的DRAM规格，因以耗电量最小化为目的，具有低电压运行特征。规格名称附有"LP（Low Power，低功耗）"，最新规格为第七代LPDDR（5X），按1-2-3-4-4X-5-5X的顺序开发而成。LPDDR5T是SK海力士业内首次开发的产品，是第八代LPDDR6正式问世之前，将第七代LPDDR（5X）性能进一步升级的产品。

自今年1月开发出LPDDR5T DRAM以来，SK海力士与高通进行了兼容性验证合作。两家公司在结合LPDDR5T DRAM和高通的最新第三代骁龙8移动平台的智能手机上进行验证得出，两款产品都发挥出了优秀的性能。

SK海力士强调："公司的LPDDR5T DRAM成功完成与全球权威通信芯片公司高通等主要移动AP（Application Processor）供应商的性能验证，今后移动设备中LPDDR5T DRAM的布局将迅速扩大。"

公司计划向客户提供以LPDDR5T DRAM单品芯片结合而成的16GB（千兆）容量套装产品。该产品的数据处理速度为每秒77GB，其相当于1秒内可处理15部全高清（Full-HD，FHD）级电影。

另外，LPDDR5T DRAM可在国际半导体标准化组织（JEDEC）规定的最低电压标准范围1.01~1.12V（伏特）下运行，在功耗方面也具备了优势。

SK海力士技术团队在开发该产品的过程中，采用了HKMG（High-K Metal Gate）*工艺，在运行速度和功耗方面都有效提高了性能。由此公司期待，在下一代的LPDDR6 DRAM问世前，LPDDR5T DRAM在移动DRAM市场上占据很大比重。

*HKMG：在DRAM晶体管内的绝缘膜上采用高K栅电介质，在防止漏电的同时还可改善电容（Capacitance）的新一代工艺。不仅可以提高内存速度，还可降低功耗。SK海力士于去年11月在移动DRAM上全球首次采用了HKMG工艺。

高通技术公司产品管理高级副总裁（Senior Vice President of Product Management）Ziad Asghar表示："第三代骁龙8产品可以低功耗下无延迟驱动生成型AI为基础的大语言模型（LLM）和大视觉模型（LVM）。骁龙移动平台和SK海力士的最高速移动DRAM相结合，智能手机用户将能够体验惊人的AI功能。"

SK海力士DRAM商品企划担当副社长柳成洙表示："LPDDR5T DRAM成功满足了全球客户对超高性能移动DRAM需求，对此感到很高兴。"

柳副社长还补充道："预计今后智能手机将成长为驱动AI技术的核心应用。为此，需要通过移动DRAM持续提高智能手机的性能，公司将继续加强与高通的合作，努力提高该领域的技术能力。"

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/202031.html